

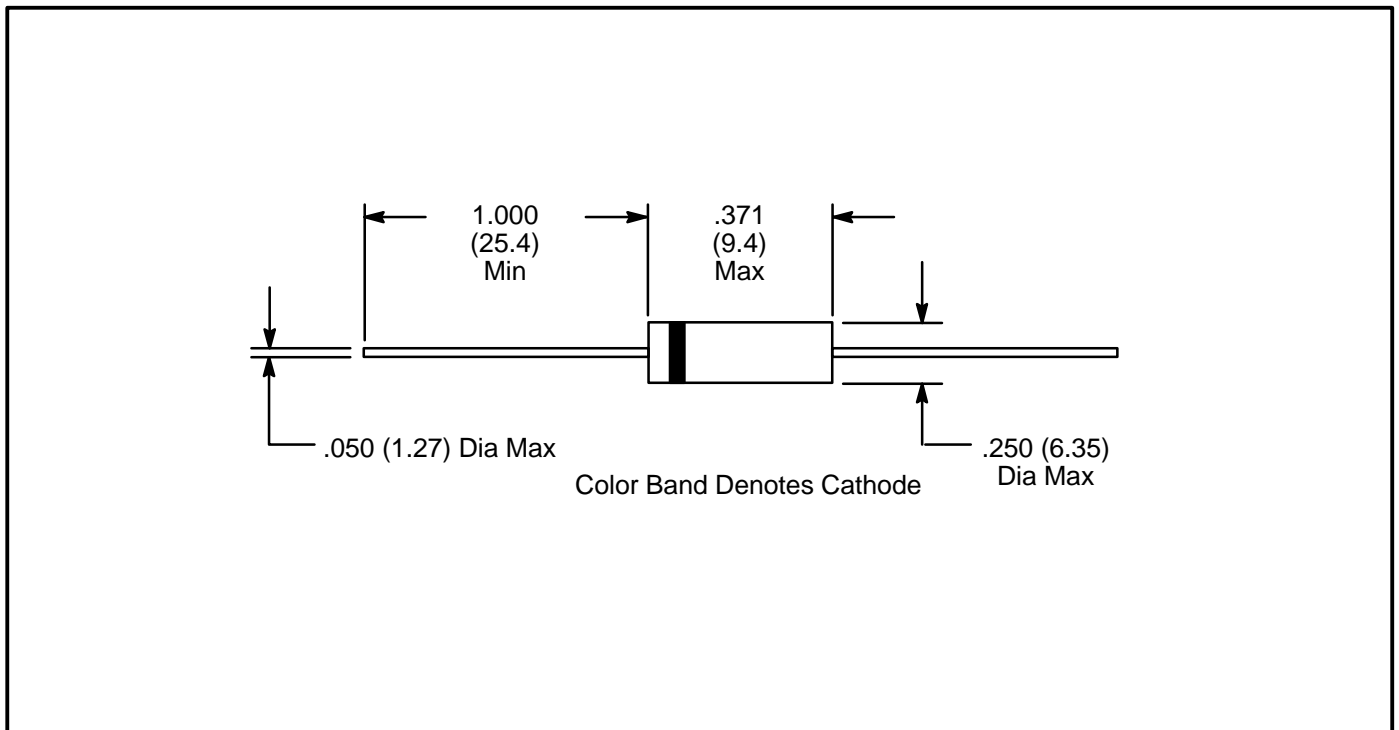


ELECTRONICS, INC.
44 FARRAND STREET
BLOOMFIELD, NJ 07003
(973) 748-5089

NTE577 Silicon Diode General Purpose, Fast Recovery Switch

Electrical Characteristics:

Maximum Peak Reverse Voltage, P_{RV}	1000V
Maximum Average Rectified Current ($T_A = +50^\circ$, half-wave, resistive load 60Hz), I_O	5A
Maximum Forward Peak Surge Current (8.3ms superimposed), I_{FSM}	200A
Maximum Reverse Current ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $P_{RV} = 1000\text{V}$), I_R	10 μA
Maximum Forward Voltage ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $I_F = 5\text{A}$), V_{FM}	1.7V
Maximum Reverse Recovery Time, t_{rr}	70ns
Operating Temperature Range, T_{opr}	-65° to +150°C
Storage Temperature Range, T_{stg}	-65° to +150°C



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Diodes - General Purpose, Power, Switching category](#):

Click to view products by [NTE manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[MCL4151-TR3](#) [MMBD3004S-13-F](#) [RD0306T-H](#) [RGP30G-E373](#) [BAQ333-TR](#) [BAQ335-TR](#) [BAQ33-GS18](#) [BAS1602VH6327XT](#) [BAV17-TR](#) [BAV19-TR](#) [BAV301-TR](#) [BAW27-TAP](#) [NSVBAV23CLT1G](#) [NTE525](#) [1SS181-TP](#) [1SS184-TP](#) [1SS193,LF](#) [1SS193-TP](#) [1SS400CST2RA](#) [SBAV99LT3G](#) [SDAA13](#) [LL4448-GS18](#) [SHN2D02FUTW1T1G](#) [LS4150GS18](#) [LS4151GS08](#) [SMMBD7000LT3G](#) [1N4449](#) [1N4934-E3/73](#) [APT100DL60HJ](#) [RFUH20TB3S](#) [RGP30G-E354](#) [RGP30M-E3/73](#) [D291S45T](#) [MCL4151-TR](#) [BAS 16-02L E6327](#) [BAS 16-02V H6327](#) [BAS 21U E6327](#) [BAS 28 E6327](#) [BAS33-TAP](#) [BAS 70-02V H6327](#) [BAV300-TR](#) [BAV303-TR3](#) [BAW27-TR](#) [BAW56DWQ-7-F](#) [BAW56M3T5G](#) [BAW75-TAP](#) [BAW76-TR](#) [MM230L-CAA](#) [MMSD914-TP](#) [IDW40E65D1](#)